

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 27 年 11 月 19 日 (2015.11.19)

【公表番号】特表 2014-530280 (P2014-530280A)

【公表日】平成 26 年 11 月 17 日 (2014.11.17)

【年通号数】公開・登録公報 2014-063

【出願番号】特願 2014-534790 (P2014-534790)

【国際特許分類】

C 0 8 L 83/07 (2006.01)

C 0 8 L 83/05 (2006.01)

C 0 8 K 5/07 (2006.01)

C 0 8 K 5/5419 (2006.01)

H 0 1 L 23/29 (2006.01)

H 0 1 L 23/31 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 83/07

C 0 8 L 83/05

C 0 8 K 5/07

C 0 8 K 5/5419

H 0 1 L 23/30 R

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 9 月 29 日 (2015.9.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

改善された熱安定性を有するゲルを形成する方法であって、(A) 1 分子当たり少なくとも平均 0.1 個のケイ素結合アルケニル基を有する有機ポリシロキサン、(B) 1 分子当たり少なくとも平均 2 個のケイ素結合水素原子を有する架橋剤、(C) ヒドロシリル化触媒、及び (D) 鉄アセチルアセトナートの加熱された反応生成物を組み合わせることを含み、前記鉄アセチルアセトナートが、加熱前に、(A) 及び (B) の総重量に基づいて 0.05 ~ 30 重量%の量で存在し、(A) 及び (B) が (C) 及び (D) の存在下で、ヒドロシリル化を介して反応して前記ゲルを形成し、かつ、(D) が、(E) シリコーン流体の存在下、少なくとも 120 の温度で鉄アセチルアセトナートを加熱することにより形成される、方法。

【請求項 2】

前記ゲルが、225 で 1000 時間の加熱老化後に測定されるように、TA-23 プローブを前記ゲルの中に 3 mm の深さまで挿入するために必要な重量として計算される、1500 グラム未満の硬度を有する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

(E) が、非官能性シリコーン流体である、請求項 1 または 2 に記載の方法。

【請求項 4】

(A) 及び (B) が、(C) 及び (D) の存在下で、(E) 官能性シリコーン流体と、ヒドロシリル化反応を介して反応する、請求項 1 または 2 に記載の方法。

【請求項 5】

前記鉄アセチルアセトナートが、前記鉄アセチルアセトナート及び（Ｅ）の総重量に基づいて、０．１～１０重量％の量で、（Ｅ）前記シリコン流体と組み合わせる、請求項１または２に記載の方法。

【請求項６】

改善された熱安定性を有し、

（Ａ）１分子当たり少なくとも平均０．１個のケイ素結合アルケニル基を有する、有機ポリシロキサンと、

（Ｂ）１分子当たり少なくとも平均２個のケイ素結合水素原子を有する、架橋剤と、のヒドロシリル化反応生成物である、ゲルであって、

（Ａ）及び（Ｂ）が、

（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、及び

（Ｄ）鉄アセチルアセトナートの加熱された反応生成物の存在下で、ヒドロシリル化を介して反応し、前記鉄アセチルアセトナートが、加熱前に、（Ａ）及び（Ｂ）の総重量に基づいて、０．０５～３０重量％の量で存在し、かつ、（Ｄ）が、（Ｅ）シリコン流体の存在下、少なくとも１２０の温度で鉄アセチルアセトナートを加熱することにより形成される、ゲル。

【請求項７】

２２５で１０００時間の加熱老化後に測定されるように、ＴＡ－２３プローブを前記ゲルの中に３ｍｍの深さまで挿入するために必要な重量として計算される、１５００グラム未満の硬度を有する、請求項６に記載のゲル。

【請求項８】

電子構成要素及び改善された熱安定性を有するゲルを備える、電子物品であって、前記ゲルが、前記電子構成要素上に配設され、

（Ａ）１分子当たり少なくとも平均０．１個のケイ素結合アルケニル基を有する、有機ポリシロキサンと、

（Ｂ）１分子当たり少なくとも平均２個のケイ素結合水素原子を有する、架橋剤と、のヒドロシリル化反応生成物であり、

（Ａ）及び（Ｂ）が、

（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、及び

（Ｄ）鉄アセチルアセトナートの加熱された反応生成物の存在下で、ヒドロシリル化を介して反応し、前記鉄アセチルアセトナートが、加熱前に、（Ａ）及び（Ｂ）の総重量に基づいて、０．０５～３０重量％の量で存在する、電子物品。

【請求項９】

前記電子構成要素がチップであり、前記ゲルが前記チップを被包し、前記電子物品が絶縁ゲートバイポーラトランジスタである、請求項８に記載の電子物品。